【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成19年9月20日(2007.9.20)

【公開番号】特開2006-161121(P2006-161121A)
【公開日】平成18年6月22日(2006.6.22)
【年通号数】公開・登録公報2006-024
【出願番号】特願2004-356224(P2004-356224)
【国際特許分類】
Ｃ２３Ｃ　14/32　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ２３Ｃ　14/32　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成19年8月7日(2007.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
〔比較例１〕
比較例１として、図２に示した従来の装置を用いた。ターゲット10にはTiAlを使用し、基材には高速度工具鋼で作成した試験片（6mm ×6mm ×40mm：母材硬さ66.0 HRC、研磨面粗さ Ry 0.2 μｍ）を用いた。真空排気で10～2 Paまで排気した後、図示していない加熱用ヒータで 450℃に加熱保持をした。それからボンバード工程として、 Ａｒガスを導入して10Paを維持し、装着した基材にグロー放電が維持できる－500 Ｖを印加して陰極を構成する基材９と陽極を構成する真空容器１の２極でグロー放電プラズマを形成させて基材表面のボンバードを20分間行った。ボンバード終了後の成膜工程では、反応ガスとして窒素ガスN_2 を用いて、真空に排気しながら 4Paに保持し、ターゲットに印加してアーク放電を起こしＴｉＡｌを蒸発させた。このときのアーク放電電流は50Ａである。基材はバイアス電圧-100Ｖを印加して所定時間成膜を行い、基材表面にＴｉＡｌＮを３μｍ形成した。